



Toshiba espande la linea di MOSFET a canale N da 80 V che supporta i sistemi automotive a 48 V

I dispositivi raggiungono una bassa resistenza di on per assicurare il risparmio energetico nei sistemi a 48 V e sono alloggiati in un package con fianchi bagnabili che agevola l'ispezione ottica automatizzata migliorando l'affidabilità in produzione

Düsseldorf, Germania, 12 maggio 2026 – Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba ») introduce due MOSFET a canale N da 80 V conformi allo standard AEC-Q101, che espandono la gamma a supporto dei sistemi automotive a 48 V. I MOSFET XPH2R608QB e XPH3R908QB sono i primi prodotti realizzati nel processo U-MOSX-H di ultima generazione ad essere alloggiati in un package SOP Advance (WF) con fianchi bagnabili.

Grazie al processo U-MOSX-H di Toshiba, i prodotti raggiungono una bassa resistenza di on ($R_{DS(ON)}$), che consente ai progettisti di massimizzare l'efficienza dei sistemi a 48 V, migliorando così le prestazioni e prolungando la durata della batteria dell'auto. I dispositivi XPH2R608Q offrono una $R_{DS(ON)}$ di 2,55 m Ω (max.), con una carica totale di gate (Qg) di 95 nC (tip.), mentre la versione XPH3R908QB presenta 3,9 m Ω (max.) e 63 nC (tip.) – entrambi con una tensione gate-source (VGS) di 10 V (max.).

Inoltre, il package SOP WF con una struttura di connettore in rame riduce la resistenza del package MOSFET, aumentando l'efficienza, migliorando la dissipazione del calore e incrementando l'affidabilità del sistema. Il design con fianco bagnabile dell'alloggiamento migliora la visibilità dei filetti di saldatura e rende più facile verificare le condizioni di montaggio su scheda attraverso apparecchiature di ispezione ottica automatizzata (AOI), migliorando l'affidabilità complessiva del sistema.

I MOSFET XPH2R608QB e XPH3R908QB sono adatti per l'utilizzo nei motori DC brushless a canale N (BLDC) e nei circuiti convertitori DC-DC buck non isolati. Oltre ai sistemi automotive a 28 V, altre applicazioni includono azionamenti per motori, alimentatori a commutazione e interruttori di carico. La gamma della serie automotive da 80 V nel processo U-MOSX-H include anche la versione XPQR8308QB, con package L-TOGL ad

alta dissipazione di calore. Toshiba continuerà a sviluppare MOSFET per applicazioni automotive adatte a sistemi a 48 V che soddisfano le diverse esigenze dei clienti e supportano varie applicazioni automotive.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:

[XPH2R608QB](#)

[XPH3R908QB](#)

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, di controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli hard disk, l'ampio portafoglio dell'azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che vanno dai diodi ai circuiti integrati logici, ai semiconduttori ottici, ai microcontrollori e ai prodotti standard specifici per un'applicazione (ASSP), tra gli altri. Inoltre, TEE offre anche celle e moduli per batterie SCiB™ con ossido di litio e titanio (LTO) per applicazioni pesanti.

TEE ha la propria sede centrale a Düsseldorf, in Germania, con filiali in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito che forniscono servizi di marketing, vendita e logistica.

Visitate i siti Web di Toshiba all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com e www.scib.jp/en per maggiori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti.

Indirizzo di riferimento per le pubblicazioni:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)7464 493526

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Pretzl

Tel: +49 (0) 172 617 8431

Web: www.pretzl.com

E-mail: birgit.schoeniger@pretzl.com